

Silicon Super Fast Recovery Diode

$V_{RRM} = 50 \text{ V} - 200 \text{ V}$

$I_F = 50 \text{ A}$

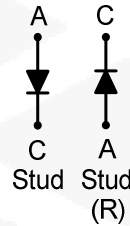
Features

- High Surge Capability
- Types from 50 V to 200 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-5 Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

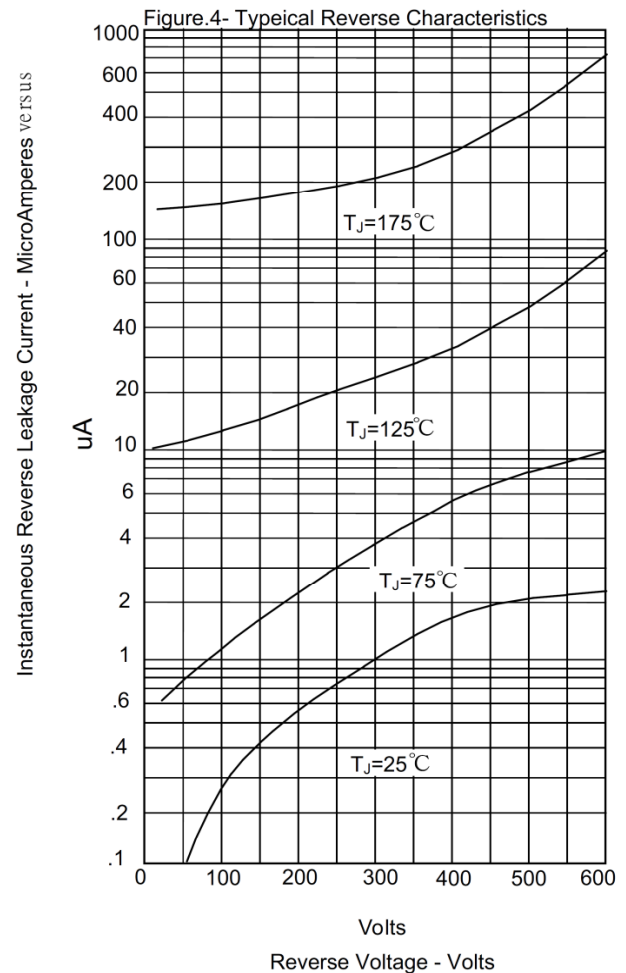
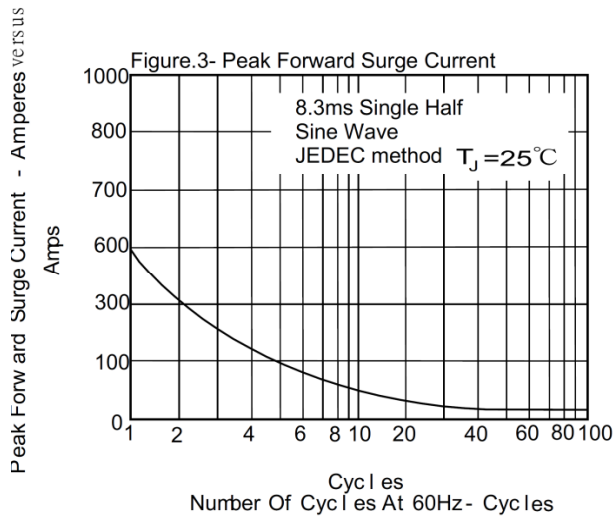
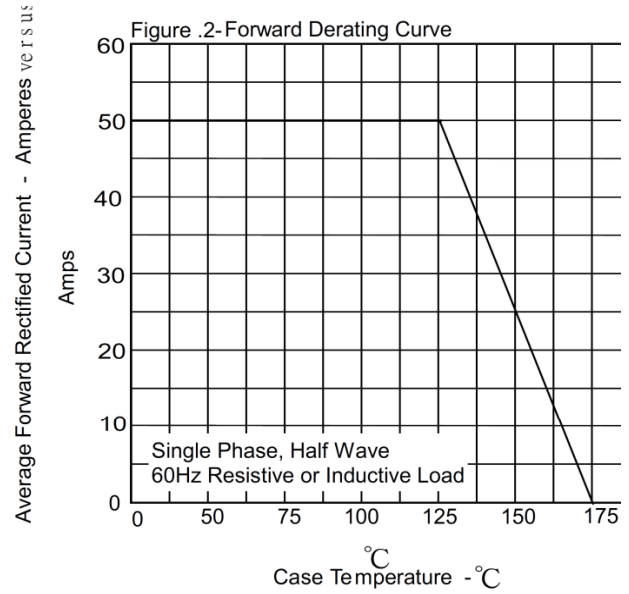
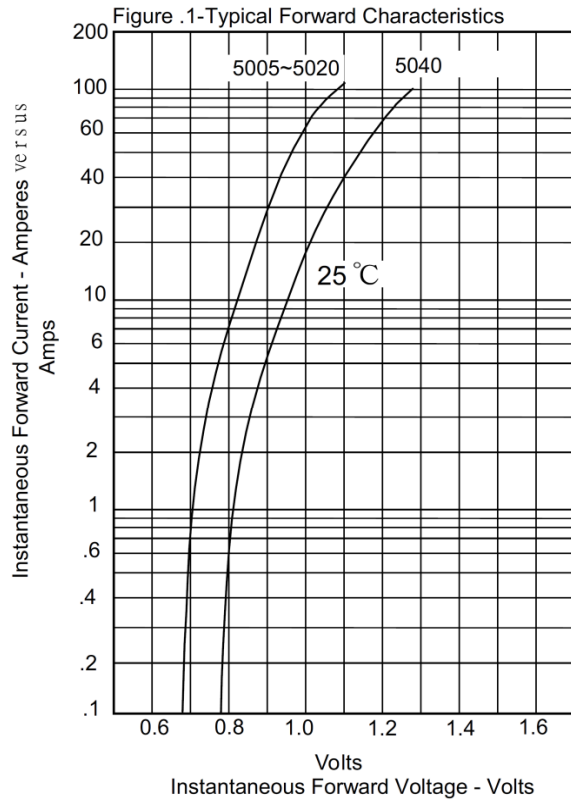
Parameter	Symbol	Conditions	MUR5005 (R)	MUR5010 (R)	MUR5020 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	70	140	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 125^\circ\text{C}$	50	50	50	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 8.3 \text{ ms}$	600	600	600	A
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MUR5005 (R)	MUR5010 (R)	MUR5020 (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 50 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1	1	1	V
Reverse current	I_R	$V_R = 50 \text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	10	10	10	μA
		$V_R = 50 \text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	3	3	3	mA

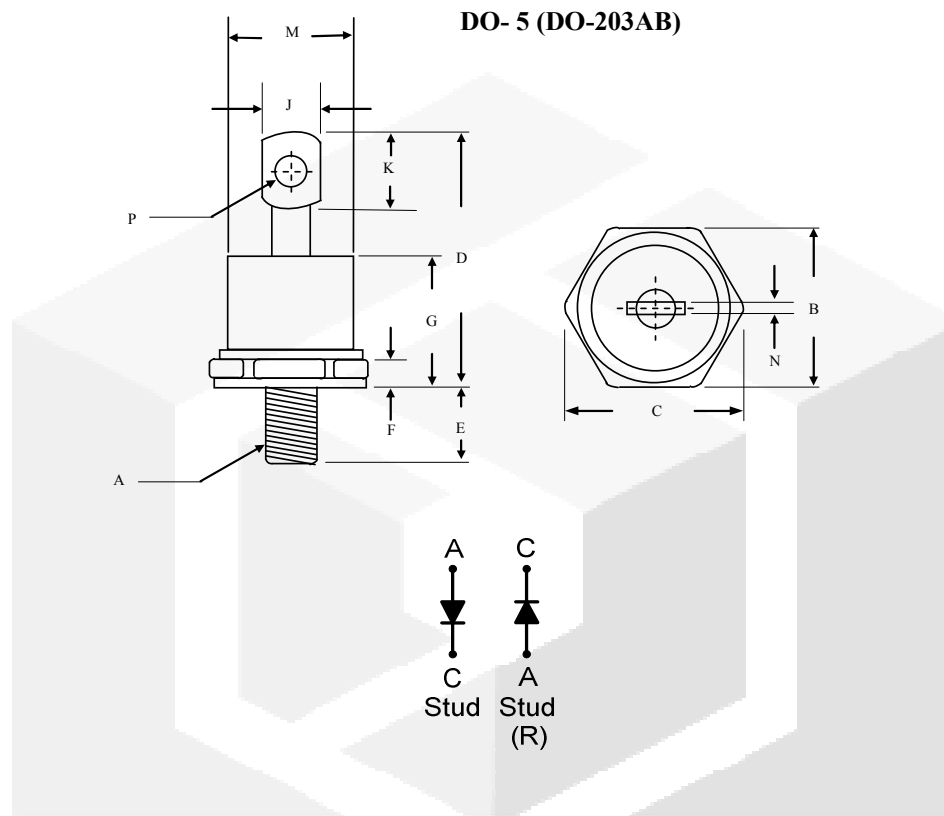
Recovery Time

Maximum reverse recovery time	T_{RR}	$I_F = 0.5 \text{ A}$, $I_R = 1.0 \text{ A}$, $I_{RR} = 0.25 \text{ A}$	75	75	75	ns
-------------------------------	----------	---	----	----	----	----



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	1/4 -28 UNF			
B	0.669	0.687	17.19	17.44
C	----	0.794	----	20.16
D	----	1.020	----	25.91
E	0.422	0.453	10.72	11.50
F	0.115	0.200	2.93	5.08
G	----	0.460	----	11.68
J	----	0.280	----	7.00
K	0.236	----	6.00	----
M	----	0.589	----	14.96
N	----	0.063	----	1.60
P	0.140	0.175	3.56	4.45

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9